# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-334207

(43) Date of publication of application: 07.12.1999

(51)Int.CI.

B41M 5/26

C09B 47/00

(21)Application number: 10-145829

45829 (71)Applicant:

MITSUBISHI CHEMICAL CORP

(22)Date of filing:

27.05.1998

(72)Inventor:

NAGAO TAKUMI

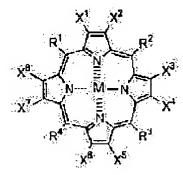
FUJITA RIEKO

#### (54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To deal with a blue laser beam by incorporating a porphyrin compound represented by a specific formula in a record layer.

SOLUTION: The optical recording medium comprises a substrate and a record layer containing a porphyrin compound represented by a specific formula. As the substrate, a material which is transparent to a laser beam is preferable, and a glass or a plastic is used. In the formula representing the porphyrion compound, as each of substitutents represented by R1 to R4, a hydrogen atom, an alkyl group such as a methyl group, ethyl group, n-propyl group or the like is used, as each of substituents represented by X1 to X8, a hydrogen atom, an alkyl group such as a methyl group, ethyl group, n-propyl group, isopropyl group or the like, alkoxy group, alkylcarbonyl group or the like is used, wherein all of the X1 to X8 do not become a non-substituted alkyl groups. Further, as M, a hydrogen atom or a metal atom is used. Thus, a light resistance and a heat resistance can be improved at low cost.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# 四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

### 特開平11-334207

(43)公開日 平成11年(1999)12月7日

(51) Int.CL 6		織別紀号	<b>P</b> 1	
B41M	5/26		B41M 5/26 Y	
C09B	47/00		CO9B 47/00	
G11B	7/24	516	G11B 7/24 516	

#### 審査請求 京請求 請求項の数2 OL (全 10 四)

(21)出顧番号	物職平10−145929	(71)出廟人 000005968 三菱化学株式会社
(22)出版日	平成10年(1998) 5月27日	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(ve) HWH H	1 Mars - Cross of Jan 11	(72) 発明者 長昭 卓美
		神祭川県横浜市青菜区鴨志田町1000番地
		三紫化学株式会社横浜総合研究所内
		(72)発明者 藤田 理惠子 神奈川県横浜市脊巣区鴨志田町1000番池
		三菱化学株式会社投资総合研究所内
		(74)代理人 弁理士 重野 剛
		1

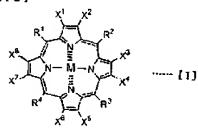
#### (54) 【発明の名称】 光学記録媒体

#### (52)【要約】

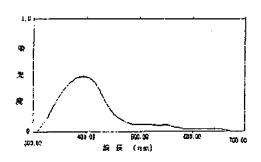
【課題】 ボルフィリン系化合物を記録層に用いた青色 レーザー対応の光学記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板上にレーザーによる情報の書き込み 及び/又は読み取りが可能な記録層が設けられた光学記 録媒体において、記録層が下記式[I]で示されるポルフィリン系化合物を含有する光学記録媒体

### 【化12】



(R'~R'はH又はアルキル基。X'~X"はアルキル基。アルコキシカルボニルアルキル基等。ただし、X"~X"のすべてが非菌族のアルキル基となることはない。MはH又は金属原子。)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にレーザーによる情報の書き込み 及び/又は読み取りが可能な記録層が設けられた光学記 録媒体において、該記録層が下記一般式 [ ! ] で示され\*

1

([1] 式中、R1、R1、R1、R1は水素原子又はアル キル基を表し、X'、X'、X'、X'、X'、X'、X'、X'、 X°はそれぞれ独立して水素原子。アルキル基、アルコ キシ蟇、アルキルカルボニル基、アルケニル基。ハロゲ ン原子、ヒドロキシル基。カルボキシル基、ヒドロキシ アルキル基、カルボキシルアルキル基、アルコキシカル ボニル基、アルキルカルボニルオキシ基、ニトロ基、シ ル基。アルコキシカルボニルアルキル基。アルキルチオ 基、アルキルスルホニル基、-NR'R'º、-CONR' R<sup>10</sup> (R<sup>1</sup>、R<sup>10</sup>はそれぞれ独立して水素原子、アルキ ル基。アルケニル基、アリール基、アラルキル基。アル コキシアルキル墓、アルキルカルボニル基、又はヒドロ キシアルキル墓を表す。また、R°とR°では互いに結合 するか、アミノ基又はアミド基の置換した環と結合して 環状を形成してもよい。)、フルオロアルキル基、フル オロアルコキシ基、フルオロアルキルチオ基を表し、M は水素原子又は金属原子を表す。ただし、X゚~X゚のす 30 ことが検討されている。 べてが非遺鏡のアルキル墓となることはない。)

【請求項2】 書き込み及び読み取りのレーザー波長が ともに350~530amであることを特徴とする請求 項1に記載の光学記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポルフィリン系化 合物を記録層に用いた青色レーザー対応の光学記録媒体 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】レーザーを用いる光学記録は、高密度の 情報記録保存及びその再生を可能とするため、近年、特 に開発が取り進められている。

【0003】とのような光学記録媒体の一例としては光 ディスクを挙げることができる。

【①①①4】一般に、光ディスクは、円形の基体に設け **られた薄い記録層に、1μm程度に収束したレーザー光** を照射し、高密度の情報記録を行うものである。中でも 最近注目を集めているものに、書き込み型コンパクトデ ィスク(CD-R)がある。CD-Rは通席、案内溝を 50 r. I、CIO。、BF1のいずれかを表す。)

\* るポルフィリン系化合物を含有することを特徴とする光 学記録媒体。

[4k 1 ]

(2)

····· [1]

有するプラスチック基板上に色素を主成分とする記録 層、金属反射膜及び保護膜を順次積層することにより機 成される。情報の記録は、照射されたレーザー光エネル ギーの吸収によって、その箇所の記録層、反射層又は基 板に、分解、蒸発、溶解等の熱的変形が生成することに より行われる。また、記録された情報の再生は、レーザ 一光により変形が起きている部分と起きていない部分の アノ甚、ホルミル基、スルホン酸基.アルコキシアルキ 20 反射率の差を読み取ることにより行われる。従って、光 学記録媒体としてはレーザー光のエネルギーを効率よく 吸収する必要があり、レーザー吸収色素が用いられる。 【0005】そして、レーザー吸収色素として有機色素 を利用した光学記録媒体は、有機色素溶液の塗布による 簡単な方法で記録層を形成し得るため、安価な光学記録 媒体としてますます普及することが期待され、その結 果、より一層の高密度化が要望されている。このため、 記録に用いるレーザー光を従来の780mmを中心とし た半導体レーザーから、青色光領域にまで短波長化する

> 【①①06】従来、青色レーザーによる記録、再生が可 能な光学記録媒体として、記録層に次のような、ポルフ ィン核に導入された置換基がすべてエチル基であるポル フィリン系化合物、具体的にはMがPbであるオクタエ チルボルフィンを用いたものが提案されている(特関平 8-127174号公報)。

[0007]

(4t2)

40

【0008】(但し、MはPb、BiO、ReOのいず れかを寂し、X、Yはフェノキシ基、NO、CI、B

待関平11-334207

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】特開平8-12717 4号公銀に記載されるボルフィリン系化合物を用いた光 学記録媒体であれば、青色レーザーによる記録。再生が 可能であるが、より一層の記録、再生特性の向上と、よ り一層広範な有機色素の開発が整まれているのが現状で ある.

3

【0010】本発明は上記従来の実情に鑑みてなされた ものであって、ポルフィリン系化合物を記録層に用いた 青色レーザー対応の光学記録媒体を提供することを目的 10 とする。

#### $\{0011\}$

【課題を解決するための手段】本発明の光学記録媒体 は、基板上にレーザーによる情報の書き込み及び/又は 読み取りが可能な記録層が設けられた光学記録媒体にお いて、該記録層が下記一般式[[]]で示されるポルフィ リン系化合物を含有することを特徴とする。

#### [0012]

#### [fk3]

$$\begin{array}{c|c}
X^1 & X^2 \\
X^3 & N-M-N \\
X^7 & R^3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
X^1 & X^2 \\
N-M-N & X^3 \\
\hline
N-M-N & X^4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
X^3 & \dots & [1]
\end{array}$$

【0013】([i]]式中、R1、R1、R1、R1は水素 原子又はアルキル基を表し、X1、X1、X1、X1、 X1, X1, X1, X1, X1はそれぞれ独立して水素原子。アルー30 n - プロボキシ蟇、イソプロボキシ蟇。n - ブトキシ キル基、アルコキシ基、アルキルカルボニル基、アルケ ニル蟇、ハロゲン原子、ヒドロキシル蟇、カルボキシル 基。ヒドロキシアルキル基。カルボキシルアルキル基、 アルコキシカルボニル基。アルキルカルボニルオキシ 基。ニトロ基。シアノ基。ホルミル基。スルホン酸基、 アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニルアルキル 基」アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、- N R\* R10. -CONR'R10 (R1, R10はそれぞれ独立して 水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ア ル基、又はヒドロキシアルキル基を表す。また、R°と RPは互いに結合するか、アミノ基又はアミド華の置換 した頃と結合して環状を形成してもよい。)、フルオロ アルキル基、フルオロアルコキシ基。フルオロアルキル チオ基を表し、Mは水素原子又は金属原子を表す。ただ し、X\*~X\*のすべてが非面換のアルキル基となること はない。)即ち、本発明者らは上記目的を達成するべく 鋭意検討した結果、特関平8-127174号公報に記 載されるボルフィン核に導入された置換基がすべてエチ

記一般式 [ ! ] で示されるポルフィリン系化合物を記録 歴に使用した光学記録媒体が、青色レーザーで良好に記 緑できることを見出し、本発明を完成させた。

【①①14】本発明に係るポルフィリン系化合物は、波 長350~530mmの青色光鎖域にモル吸光係数が大 きく、シャープな吸収 (Soret帯) を有し、青色レ ーザーでの記録に適する。また、ボルフィリン系化合物 の中では合成が比較的容易であることから、安価な光学 記録媒体を提供することができる。更に、高い光安定 性、耐熱性を有し、安定性が要求される光学記録媒体に 好酒である。

#### [0015]

(3)

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を詳細 に説明する。

【① 0 1 6 】本発明に係るポルフィリン系化合物を示す 前記一般式[I]において、R'~R'で表される面換基 としては、水素原子;メチル基、エチル基、カープロピ ル基。イソプロビル基、n-ブチル基。tert-ブチ ル墓」sec-ブチル基。n-ペンチル基、n-ヘキシ 20 ル基等の置換されていても良い炭素数1~20の直鎖又 は分岐のアルキル基が挙げられる。

【① 0 1 7 】また、前記一般式 [ ! ] において、X! ~ X"で表される置換基としては水素原子:メチル基、エ チル基、カープロピル基。イソプロピル基、カーブチル 基」もeょt~ブチル基」sec~ブチル基、n‐ペン チル基、カーヘキシル基等の炭素数1~20の直鎖又は 分岐のアルキル基;シクロプロピル基、シクロプチル 基。シクロベンチル基、シクロヘキシル基等の炭素数3 ~10の躁状のアルキル墓;メトキシ墓、エトキシ基、 基。もert-ブトキシ墓。sec-ブトキシ蟇。n-ペンチルオキシ蟇、n-ヘキシルオキシ基等の炭素数! ~20の直鎖又は分岐のアルコキシ墓;アセチル墓、ブ ロビオニル基。ブチリル基。イソブチリル基、バレリル 基。イソバレリル基、ピバロイル基。ヘキサノイル基、 ヘブタノイル募等の炭素数2~21の直鎖又は分岐のア ルキルカルボニル基;ビニル基、プロペニル基。プテニ ル基、ペンテニル基、ヘキセニル基等の炭素数2~20 の直鎖又は分岐のアルケニル基、シクロベンテニル基、 ラルキル基、アルコキシアルキル基、アルキルカルボニ 40 シクロヘキセニル基等の炭素数3~10の環状のアルケ ニル草:フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロゲン 原子;ヒドロキシル基;カルボキシル墓;ヒドロキシメ チル基、ヒドロキシエチル基等の炭素数1~20のヒド ロキシアルキル墓:カルボキシルメチル基、2-カルボ キシルエチル基、3-カルボキシルプロピル基等の炭素 数1~20の直鎖又は分岐のカルボキシルアルキル基: メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基。n-ブ ロボキシカルボニル基、イソプロボキシカルボニル基、 n-ブトキシカルボニル基。 tert-ブトキシカルボ ル基となっているポルフィリン系化合物とは異なる、上 50 ニル苺、sec-ブトキシカルボニル苺、n-ベンチル

7/23/03 2:45 PM

(4)

オキシカルボニル基、n-ヘキシルオキシカルボニル基 等の炭素数2~21の直鎖又は分岐のアルコキシカルボ ニル基;メチルカルボニルオキシ基。エチルカルボニル オキシ基、n-プロピルカルボニルオキシ基、イソプロ ピルカルボニルオキシ基。n-ブチルカルボニルオキシ 基。tegt-ブチルカルボニルオキシ基、sec-ブ チルカルボニルオキシ基。n-ベンチルカルボニルオキ シ基 カーヘキシルカルボニルオキシ基等の炭素数2~ 21の直鎖又は分岐のアルキルカルボニルオキシ墓;ニ トロ墓;シアノ墓;ホルミル基;スルホン酸基;メトキー10 チオ墓、パーフルオローn-ブチルチオ基、パーフルオ シメチル基、メトキシエチル基、エトキシメチル基、エ トキシエチル基。カープロポキシエチル基、カープロポ キシプロピル墓。イソプロポキシメチル基、イソプロポ キシエチル基等の炭素数2~21の直鎖又は分岐のアル コキシアルキル墓;メトキシカルボニルメチル墓。メト キシカルボニルエチル基。エトキシカルボニルメチル。 基。エトキシカルボニルエチル基。n-プロボキシカル ボニルエチル基。カープロポキシカルボニルプロビル 基。イソプロポキシカルボニルメチル基、イソプロポキ 岐のアルコキシカルボニルアルキル墓;メチルチオ基、 エチルチオ基 m-プロビルチオ基 イソプロビルチオ 基。n-ブチルチオ基、tegt-ブチルチオ基。se cープチルチオ基、nーペンチルチオ基、nーヘキシル チオ基等の炭素数1~20の直鎖又は分岐のアルキルチ オ蟇;メチルスルホニル蟇」エチルスルホニル蟇」カー プロビルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、n ープチルスルホニル基、tert-ブチルスルホニル 基.sec-ブチルスルホニル基、n-ペンチルスルホ エル基、n-ヘキシルスルホニル基等の炭素数1~20 の直鎖又は分岐のアルキルスルホニル基: - NR\*R\*\* (R\*, R\*\*はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1~ 12の直鎖又は分岐のアルキル基、炭素数2~12の直 鎖又は分岐のアルケニル基、置換基を有していてもよい フェニル基等のアリール基、炭素数7~20の直鎖又は 分岐のアラルキル基、炭素数2~12の直鎖又は分岐の アルコキシアルキル基、炭素数2~12の直鎖又は分岐 のアルキルカルボニル基;炭素数1~12の直鎖又は分 岐のヒドロキシアルキル基を表す。また、R°とR\*\*は 互いに結合するか、又はアミノ基の窗換した環と結合し 40 いてもよいフェニル基を表わす。)。 て環状を形成してもよい。);-CONR'R'"(R', R10の定義は上記と同様。);トリフルオロメチル基、 ペンタフルオロエチル基。ヘブタフルオローnープロピ ル基。ヘフタフルオロイソプロピル基。パーフルオロー n-ブチル基。パーフルオロー1ert-ブチル基。パ ーフルオローSec-ブチル基、パーフルオローn-ペ ンチル基、パーフルオローnーヘキシル基等の炭素数1 ~2()の直鎖又は分岐のフルオロアルキル基:トリフル

オロメトキシ蟇」ペンタフルオロエトキシ基、ヘプタフ ルオローカープロボキシ華。ヘブタフルオロイソプロボ キシ基、パープルオローn-ブトキシ基、パープルオロ - tert-ブトキシ基、パーフルオローsec‐ブト キシ墓、パーフルオローa-ペンチルオキシ基。パーフ ルオローカーヘキシルオキシ基等の炭素数1~20の直 鎖又は分岐のフルオロアルコキシ基:トリフルオロメチ ルチオ基、ペンタフルオロエチルチオ基、ヘブタフルオ ローホープロビルチオ基。ヘプタフルオロイソプロピル ローもeょもっプチルチオ基、パーフルオローSec-ブチルチオ基。パーフルオローカーペンチルチオ基、パ ーフルオローn-ヘキシルチオ基等の炭素数1~20の 直鎖又は分岐のブルオロアルキルチオ基が挙げられる。 ただし、X1~X1のすべてが非置換のアルキル量となる ことはない。

5

【0018】前記一般式〔Ⅰ〕において、Mとしては水 素原子、又は金属原子が挙げられる。金属原子として tt. Mg, Al. Si, Ca, Sc. Ti, V. Cr, シカルボニルエチル基等の炭素数3~22の直鎖又は分 20 Mn、Fe,Co,Ni、Cu,2n、Ga,Ge,A s. Sr. Y. Zr. Nb. Mo, Tc. Ru. Rh. Pd. Ag, Cd, In. Sn, Sb. Ba, Pr, E u. Yb, Hf. Ta, W. Re, Os, Ir. Pt, Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Th等の一般にポルフ ィリン系化合物に配位する能力のある金層であれば良 く、特に制限はないが、Mg、Al、Si、Ti、V。 Mn. Fe, Co, Nr. Cu, Zn. Ga, Ge, P d. in, Sn. Pb等が好ましい。また、MがFe, in、Sn等の金属の場合は、軸配位子としてF1, C - 1 \* , B x \* , I \* 等のハロゲンイオン : OR \* , OP hr, NCST, Nat, OHr, CNT, CHaCOOT, C F,COO', BF,', PF,', C!O。 、下記構造式で 表されるp-トルエンスルホン酸イオン等のアニオン; ピリジン、イミダゾール等の塩基:NO,CO、O,等 のガス:水を有していてもよい (ここで、Rはメチル 基。エチル基。n-プロビル基、イソプロビル基。n-ブチル基、text-ブチル基、sec-ブチル基、n ベンチル基。nーヘキシル基等の炭素数1~10の直 鎖又は分岐のアルキル基を表し、Phは置換基を有して

[0019]

[化4]

【0020】本発明のポルフィリン化合物としては具体 的には以下の構造のものが挙げられる。

[0021]

[fb5]

**特闕平11-334207** (5) 7 -- [1] снасн₂соосна CH2CH2COOCH(CH3)? **--** [2] CH<sub>1</sub>CH<sub>2</sub>COOCH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ,CH₂CH₂COOCH<sub>3</sub> H<sub>2</sub>COOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>C H<sub>3</sub>C СН₂СИ₂СООСН₃ H<sub>3</sub>COOGH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>C -- [3] [0022] \* \* [化6] CH(OH)CH<sub>3</sub> н<sub>ә</sub>Ф(но₃нс ·· [4] ҇≎н₂си₂соосн₃ ··· [8] CH2CH2COOCH3 CH2CH2COOCH(CH3)2

[化?]

[0023]

特關平11-334207

(6)

(7)

特関平11-334207

12

C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>

N = C<sub>1</sub> -N

COCCH<sub>3</sub>

H<sub>3</sub>C

CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COOCH<sub>3</sub>

(15)

H<sub>3</sub>C C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>

C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>

H<sub>3</sub>C CH<sub>3</sub>

[0027] [化11]

【0028】とれらのボルフィリン系化合物は1種を単独で用いてもよいし、2種以上を複合して使用しても構わない。

【0029】とのようなポルフィリン化合物は、ビロール誘導体を原斜として公知の方法により合成することができる。或いは、天然に存在するへムを出発原斜として台成することもできる。

【0030】また、中心金属の導入は、無金属ボルフィリン系化合物を酢酸、N、N - ジメチルホルムアミド、ベンゼン、エーテル、クロロホルム。ビリジン等の有機溶媒中で、ハロゲン化物、酢酸塩、金属アセチルアセトナート錯体、金属カルボニル錯体等の金属塩と加熱することにより行うことができる。

【① 0 3 1 】本発明の光学記録媒体は、基本的には基板 と前記ポルフィリン系化合物を含む記録層とから構成さ れるものであるが、更に必要に応じて基板上に下引き層 10 を設けることができる。

【①032】前記基板としては、使用するレーザー光に対して透明なものが好ましく、ガラスや種々のプラスチックが用いられる。プラスチックとしては、アクリル樹脂、ボリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ボリカーボネート樹脂、ボリプロビレン樹脂、ボリイミド樹脂、ポリスチレン樹脂、エボキシ樹脂等が挙げられるが、高生産性、コスト、耐吸湿性の点から射出成型ポリカーボネート樹脂基板が特に好ましい。

20 【①①33】本発明の光学記録媒体におけるボルフィリン系化合物を含有する記録層の膜厚は、一般に100点~5μm、好ましくは700点~3μmである。 【①①34】との記録層は、真空蒸着法、スパッタリング法、ドクタープレード法、キャスト法、スピナー法、役債法等一般に行われている薄膜形成法で成膜することができるが、量産性、コスト面からスピナー法が好まし

【① 0 3 5 】記録層の成機に当っては、必要に応じてバインダーを使用することもできる。バインダーとしては ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン。ケトン 樹脂、ニトロセルロース、酢酸セルロース、ポリビニル ブチラール、ポリカーボネート等既知のものが用いられる。この場合、本発明に係るポルフィリン系化合物は、バインダー樹脂中に10重量%以上含有されていることが好ましい。

【0036】スピナー法による成膜の場合、回転数は500~5000 rpmが好ましく、スピンコートの後、場合によっては、加熱又は溶媒蒸気に当てる等の処理を行ってもよい。

40 【① ① 3 7 】また、記録層の安定性や耐光性向上のために、一重項酸素クエンチャーとして選移金属キレート化合物(例えば、アセチルアセトナートキレート、ビスフェニルジチオール、サリチルアルデヒドオキシム、ビスジチオー マージケトン等)等や、記録感度向上のために金属系化合物等の記録感度向上剤を含有していてもよい。ここで、金属系化合物とは、遷移金属等の金属が原子、イオン、クラスター等の形で化合物に含まれるものを言い、例えばエチレンジアミン系譜体、アゾメチン系錯体、フェニルヒドロキシアミン系譜体、フェナントロ50 リン系錯体、ジヒドロキシアゾベンゼン系錯体、ジオキ

シム系錯体、エトロソアミノフェノール系錯体。ビリジ ルトリアジン系譜体、アセチルアセトナート系譜体、メ タロセン系錯体。ポルフィリン系錯体のような有機金属 化合物が挙げられる。金属原子としては特に限定されな いが、遷移金属であることが好ましい。

13

【①①38】金属には、更に必要に応じて他系統の色素 を併用することもできる。他系統の色素としては、主と して記録用のレーザー波長域に吸収を有し、照射された レーザー光エネルギーの吸収によって、その箇所の記録 層。反射層又は基板に、分解、蒸発、溶解等の熱的変形。10 一光は高密着度記録のため、波長は短いほど好ましい を伴いピットが形成されるようなものであれば特に制限 されない。また、CD-Rのような770~830nm から選ばれた波長の近赤外レーザーやDVD-Rのよう な620~690ヵmから選ばれた赤色レーザーでの記 録に適する色素を併用して、複数の液長域のレーザーで の記録に対応する光学記録媒体とすることもできる。他 系統の色素としては、具体的には、含金属アゾ系色素、 フタロシアニン系色素、ナフタロシアニン系色素、シア ニン系色素、アゾ系色素、スクアリリウム系色素、含金 属インドアニリン系色素、トリアリールメタン系色素、 メロシアニン系色素、アズレニウム系色素、ナフトキノ ン系色素、アントラキノン系色素、インドフェノール系 色素、キサンテン系色素、オキザジン系色素、ビリリウ ム系色素等が挙げられる。

【りり39】ドクターブレード法、キャスト法、スピナ 一法、浸漬法、特にスピナー法等の塗布方法により記録 層を形成する場合の塗布溶媒としては、基板を侵さない 密媒であれば良く、特に限定されない。例えば、ジアセ トンアルコール、3-ヒドロキシー3-メチル-2-ブ タフン等のケトンアルコール系密媒、メチルセロソル。 ブ、エチルセロソルブ等のセロソルブ系溶媒、g - ヘキ サン、n-オクタン等の炭化水素系溶媒、シクロヘキサ ン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ジ メチルシクロヘキサン、n-ブチルシクロヘキサン、t **ープチルシクロヘキサン、シクロオクタン等の炭化水素** 系溶媒、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル等 のエーテル系溶媒、テトラブルオロブロバノール、オク タフルオロペンタノール。ヘキサフルオロブタノール等 のパーフルオロアルキルアルコール系溶媒、乳酸メチ ル、乳酸エチル、イソ酪酸メチル等のヒドロキシエステ 40 -ル系溶媒等が挙げられる。

【0040】また、記録層上に金、銀、アルミニウム又 はそれらの合金のような金属反射層及び保護層を設けて 高反射率の媒体としてもよい。この場合の反射層として は金、銀、アルミニウム等が挙げられるが、金やアルミ ニウムでは、本発明で使用する530 nm以下の液長の レーザー光では反射率が十分ではなく、銀であることが 好ましい。

【0041】金属反射圏は、蒸着法、スパッタリング 法。イオンプレーティング法によって成膜される。な お 金属反射層と記録層との間に層間の密着力を向上さ せるため、又は、反射率を高める等の目的で中間層を設 けてもよい。

14

【0042】保護層としては、例えば、紫外線硬化型樹 脂組成物などが挙げられる。

【0043】また、接着層を介して貼りあわせ、両面記 録型光学記録媒体としてもよいし、記録層を基板の両面 に設けてもよいし、片面に設けてもよい。

【①①44】本発明の光学記録媒体に使用されるレーザ が、特に350mm~530mmのレーザー光が好まし い。かかるレーザーの代表例としては、中心波長410 nm、515nmのレーザーが挙げられる。

【0045】波長350mm~530mmの範囲のレー ザー光は、例えば、410mmの青色又は515mmの 青緑色の高出力半導体レーザーを使用することにより得 ることができるが、その他、例えば、(a)基本発繊波 長が740~960mmの連続発振可能な半導体レーザ ー又は(h)半導体レーザーによって励起されかつ基本 20 発振波長が740~960 amの連続発振可能な固体レ ーザーのいずれかを第二高調波発生素子(SHG)によ り波長変換することによっても得ることができる。

【0046】上記のSHGとしては、反射対称性を欠く ピエゾ素子であればいかなるものでもよいが、KDP、 ADP、BNN、KN、LBO、化合物半導体などが好 ましい。第二高調波の具体例としては、基本発振液長が 860mmの半導体レーザーの場合は、その倍波の43 ① n m、また半導体レーザー励起の固体レーザーの場合 は、CェドープしたLISェA!F。結晶(基本発振波 30 長860 nm) からの倍波の430 nmなどが挙げられ る.

【0047】上記のようにして得られた光記録媒体への 記録は、基板の両面又は片面に設けた記録層に()、4~ 6 μm程度に集束したレーザー光を当てることによ り行う。これにより、レーザー光の照射された部分に は、レーザー光エネルギーの吸収による、分解、発熱、 溶融等の記録層の熱的変形が起こる。

【①①48】記録された情報の再生は、レーザー光によ り、上記熱的変形が起きている部分と超きていない部分 の反射率の差を読み取ることにより行う。

[0049]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に 説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の 箕槌倒に限定されるものではない。

【0050】実施例1

#### (a) 製造例

ジメチルホルムアミド50mlを撹拌下加熱還流させ、 プロトポルフィリン 1 X ジメチルエステル 0. 52 g (1) 88mmo!)を添加した。10分間撹拌後、F 50 eC1,・4H,O 0.44g(2.2mmol)を添

1 of 2

7/23/03 2:46 PM

(8)

(9)

加し、更に10分間鎖控した。放冷後、水中にあけ、析 出した結晶を遮別し、シリカゲルカラムで精製したとこ ろ、前記標造式[19]で示されるポルフィリン系化合 物(). 46 g (収率76.9%) が得られた。

15

【①①51】この化合物のクロロホルム中での最大吸収 波長 (入血ax) は394mmであり、分子吸光係数  $(\varepsilon)$  は8. 3×101であった。

#### 【0052】(b) 記錄媒体例

上記で得られたポルフィリン系化合物のオクタフルオロ 解液を得た。この溶液を直径120mm、厚さ1.2m mの射出成型ポリカーボネート樹脂基板上に適下し、ス ピナー法により塗布し、塗布銭、100℃で30分間乾 燥した。この塗布膜の最大吸収波長(λmax)は39 5 n mであった。塗布膜の可視部吸収スペクトルを図1 に示す。

【0053】次に、この塗布膜の上にスパッタリング法 により、膜厚1000点の銀膜を成膜して反射層を形成 した。更に、との反射層の上に紫外線硬化型樹脂をスピ ンコートし、これに紫外線を照射して硬化させ、厚み5 20 μ mの保護圏を形成した。

【0054】得られた光学記録媒体の488 n m におけ る反射率は5.5%であった。

#### 【0055】(c) 光記録法

上記光学記録媒体に、中心波長488mmのアルゴンレ ーザー光を照射したところ、良好な記録ピットを形成す ることができた。

【0056】実施例2

#### (a) 製造例

ジメチルホルムアミド50 m 」を撹拌下加熱還流させ、 メソポルフィリン [ X ジメチルエステル(). 38g (0.63mmo!)を添加した。10分間鎖拌後、F eC1,・4円,O (). 31g(1.6mmol)を添 加し、夏に10分間撹拌した。放冷後、水中にあけ、析 出した結晶を濾別し、シリカゲルカラムで精製したとこ\* \* ろ、前記構造式 [20] で示されるポルフィリン系化台 物(), () 87g (収率2(), 2%) が得られた。

【① 057】この化合物のクロロホルム中での入血ax は378nmであり、εは9、0×10<sup>4</sup>であった。

【0058】(b) 記錄媒体例

上記で得られたポルフィリン系化合物のオクタフルオロ ペンタノール 1. ()重置%溶液を調製し、濾過して、溶 解液を得た。この溶液を直径120mm、厚さ1.2m mの射出成型ポリカーボネート樹脂基板上に適下し、ス ペンタノール1.0重置%溶液を調製し、濾過して、溶 10 ピナー法により塗布し、塗布後、100℃で30分間乾 燥した。この途布膜のAmaxは375nmであった。 塗布膜の可視部吸収スペクトルを図2に示す。

> 【0059】次に、この塗布膜の上にスパッタリング法 により、膜厚1000Aの銀膜を成膜して反射層を形成 した。更に、この反射層の上に紫外線硬化型樹脂をスピ ンコートし、これに紫外線を照射して顕化させ、厚みち u giの保護層を形成した。

> 【①060】得られた光学記録媒体の488mmにおけ る反射率は52%であった。

【0061】(c) 光記録法

上記光学記録媒体に、中心液長488mmのアルゴンレ ーザー光を照射したところ、良好な記録ピットを形成す ることができた。

【0062】実施例3,4

前記構造式「3〕(実施例3)及び構造式「1〕(実施 例4)で示されるボルフィリン系化合物を台成した。と の化合物のλmax、εは表1に示す通りであった。

【0063】また、これらのポルフィリン系化合物を用 いて実施例」と同様に基板上に塗布して、表しに示す塗 30 布膜の最大吸収液長を持つ光学記録媒体を製造した。

【0064】得られた光学記録媒体に、中心波長488 nmのアルゴンレーザーを用いて記録を行ったところ、 良好な記録ビットを形成することができた。

[0065]

【表1】

実施例	構造式 No.	クロロホルム中 え max(nm)	€ (×10 <sup>4</sup> )	塗布膜 λ max(nm)
3	[3]	401	17.2	403
4	[1]	408	16.8	410

[0066]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明のポルフィリ ン系化合物を用いた光学記録媒体によれば、安価で、耐 光性、耐熱性に優れる高密度記録媒体が提供される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1で得られたポルフィリン系化合物のポ

リカーボネート基板上の塗布膜の吸収スペクトルを表す 図である。

【図2】 実施例2で得られたポルフィリン系化合物のポ リカーボネート墓板上の塗布膜の吸収スペクトルを表す 図である。

7/23/03 2:46 PM

**(10)** 

特闘平11-334207

